

**KST10 (NPN)**

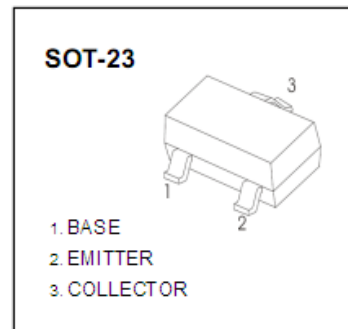
印章/Marking : 3E1

用途/Applications :

用于 VHF/UHF 电路

。

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)



参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	30	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	3	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	40	mA
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.35	W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	357	°C/mW
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	30			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=10 \mu A, I_C=0$	3			V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=25V, I_E=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=2V, I_C=0$			0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=4mA$	60			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4mA, I_B=0.4mA$			0.5	V
基极-发射极压降	V_{BE}	$V_{CE}=10V, I_C=4mA$			0.95	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=4mA, f=100MHz$	650			MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$			0.7	pF